Международная научно-техническая конференция
СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ

посвящённая
100 –летию « Нижегородской радиолаборатории»

14-15 ноября 2017 г., Нижний Новгород

организаторы:

Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи им. А.С. Попова
Нижегородское региональное отделение РНТОРЭС им. А.С. Попова
Национальный исследовательский нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева

При участии и поддержке:

- Академия инженерных наук им. А. М. Прохорова
- Нанотехнологическое общество России
- Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН
- Научно-исследовательский радиофизический институт
- Белорусский государственный университет
- Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
- Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины
- Институт физики им. Х. И. Амирханова ДНЦ РАН
- Московский физико-технический институт
- Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана
- Московский институт электронной техники
- Московский государственный технологический университет (МИРЭА)
- Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых
- Таганрогский государственный радиотехнический институт Южного федерального университета
- Воронежский государственный университет
- Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
- ЗАО НПК «Электровыпрямитель»
- Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН
- Институт физики твердого тела РАН
- Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН
- Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН
- Институт химии высокочистых веществ им. Г. Г. Девятых РАН
- Институт прикладной физики РАН
- ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
- Институт СВЧ полупроводниковой электроники РАН
- НИИ системных исследований РАН
- Физико-технологический институт РАН
- Научный центр волоконной оптики РАН
- ОАО «Интеграл» (НТЦ «Белмикросистемы»)
- Московский технический университет связи и информатики
- ФГУП «ФНПЦ «НИИ измерительных систем им. Ю. Е. Седакова»
- ОАО «ФНПЦ «ННИПИ «Кварц» им. А. П. Горшкова»
- ОАО «НПП «САЛЮТ»
- ООО «НИИ «АСОНИКА»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:

Председатель Международного Организационного комитета: академик РАН **Гапонов Сергей В**

Сопредседатели: академик РАН **Сергеев А.В.,** академик РАН **Сигов А. С.,** академик РАН **Фёдоров И. Б.,** член-корр. РАН **Зубарев Ю. Б.,** член-корр. РАН **Красильник З.Ф.,** проф. **Чупрунов Е.В.,** проф. **Дмитриев С.М.**

Председатель Программного комитета: академик РАН **Гуляев Юрий Васильевич**

Члены Программного комитета: академик РАН Литвак А. Г. (Россия), член-корр. РАН Кондратьев В.В. профессор Аджемов А.С. (Россия), проф. Баранов В.Г.(Россия), академик РАН Бугаёв А. С. (Россия), проф. Витязев В.В.(Россия), член-корр. НАНБ Гурский Л.И. (Белоруссия), академик НАНБ Достанко А.П. (Белоруссия), PhD. С. Махашабде (Швеция), член-корр. РАН Никитов С.А., к. ф.- м. н. Новиков М. А. (Россия), член-корр. НАНБ Рогачев А.В. (Белоруссия), член-корр. РАН Черепенин В. А.(Россия)

Председатель Национального Организационного комитета: проф. Туляков Ю.М.

Члены Национального организационного комитета: д.т.н. Бабанов Н.Ю., проф. Васильев К.К., д.т.н. Войткевич К.В., к.ф-м.н. Горюнов Б.М., к.т.н. Ермилов Э.А., проф. Жужома Е.В., проф. Катин С.В., к.ф-м.н. Марков К.А., проф. Матросов В.В., проф. Оболенский С.В., проф. Починка О.В., к.м.н. Пурсанов К.А., проф. Снегирёв С. Д., доц. Самсонов Г.А. , проф. Сушкова Л.Т., Федько Ю.В., проф. Хранилов В.П., проф. Чувильдеев В.Н., к.ф.-м.н. Шапошников Д.Е., Ягодкин В.Л. проф. Ямпурин Н.П.,

РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

(укажите соответствующей номер направления в заявке к докладу)

Фундаментальные и прикладные исследования

1. Электрические, оптические, структурные и химические свойства полупроводниковых материалов. Органические полупроводники и приборы на их основе. Физика полупроводниковых приборов. Приборы на квантовых эффектах. Моделирование на суперЭВМ физических процессов в материалах и компонентах электронной техники. Наноструктуры и нанотехнологии в микроэлектронике. Моделирование сложных наносистем, в том числе с использованием высокопроизводительных вычислений.

2. Радиационностойкая микроэлектроника. Космические электронные компоненты и вопросы их сертификации. Доминирующие эффекты в полупроводниковой электронной компонентной базе при воздействии импульсных и стационарных ионизирующих излучений. Математические модели электронной компонентной базы при воздействии ионизирующих излучений и внешних электромагнитных импульсов. Проектирование современных радиационностойких интегральных схем и радиационностойкой радиоэлектронной аппаратуры. Имитационное моделирование на суперЭВМ при проектировании современных радиационностойких интегральных схем.

3. Оптоэлектроника, в том числе оптоэлектронные приборы на гетероструктурах, гетероструктурная СВЧ-электроника, волоконная оптика, фотоника, акустоэлектроника, спинтроника, фрактальные радиоэлементы, пассивная элементная база: устройства и материалы, в том числе магнитные материалы. Квантовые компьютеры.

4. Технологии получения материалов для элементной базы отечественной радиоэлектроники, а также методы их исследования: сканирующая зондовая микроскопия, рентгеноструктурный анализ и др. Оптическая, рентгеновская, электронная и ионная литография. Ионная имплантация. Моделирование на суперЭВМ технологических процессов микроэлектроники. Высокочистые материалы для микро- и наноэлектроники, волоконной и силовой оптики, оптоэлектроники. Методы физического материаловедения.

5. Исследование внедрения инноваций в микро-электронике. Проблемы импортозамещения в микроэлектронике, в том числе с применением математического моделирования. Вопросы экономики, качества, надежности, диагностики и стандартизации в производстве элементной базы отечественной радиоэлектроники.

6. Интегрированные интеллектуальные системы радиолокации, гидролокации, навигации, робототехники и связи будущего. Параллельные вычисления и грид-технологии в перспективных радиотехнических системах: системах дистанционного зондирования Земли, ГЛОНАСС и. т. д., а также в гидроакустических и робототехнических системах. Микросистемная техника. Информационная безопасность.

7. Вопросы профессионального образования в нано-, микро- и радиоэлектронике. Автоматизация проектирования в нано-, микро- и радиоэлектронике. Проблемы обеспечения качества подготовки специалистов по элементной базе по дисциплинам математического цикла.

8. Нано-, микро- и радиоэлектроника в медицине и микробиологии.

Работа конференции будет организована в форме пленарного и секционных заседаний, а также проблемно-тематических круглых столов (темы уточняются)

Рабочий язык конференции – *русский*.
Доклады, включенные в Программу конференции, будут опубликованы в **Сборнике Трудов конференции,** который индексируется в **РИНЦ.**
По решению конференции расширенные версии лучших секционных докладов, сделанных ОЧНЫМИ участниками конференции, будут опубликованы в журналах, включённых в перечень ВАК.
Лучший доклад молодого специалиста будет поощрён.

СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ В СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ:
(информация о регистрации обновляется на сайте: http://www.nto-nn.ru)
***до* 15 сентября 2017 года**

ПРИЁМ ДОКЛАДОВ — НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: losev.conference.2017@gmail.com
4 ФАЙЛА + ОПЛАТА целевого взноса.

С бумажными носителями работа прекращена!
ЦЕЛЕВОЙ (РЕГИСТРАЦИОННЫЙ) ВЗНОС за один доклад:
3500 рублей Для научно-производственных организаций.
3000 рублей для преподавателей и научных сотрудников вузов, академий и их филиалов.
1500 рублей для студентов и аспирантов вузов и академий
(без соавторства с научным руководителем)
(один взнос включает: доклад + публикация + один Сборник Трудов конференции)

Слушатели приглашаются бесплатно (без предоставления "Сборника докладов Конференции").

1 **E-mail** **Заявка обязательно** для каждого соавтора (фамилия, имя, отчество, год рождения, место работы, должность, научные степень-звание, E-mail для переписки, телефон, факс, **почтовый адрес с индексом**); в этих сведениях указать название направления. Название всех файлов должны начинаться с фамилии автора.

2 **E-mail** **ДОКЛАД** (до 4 страниц) на русском языке (требования к оформлению в ПРИЛОЖЕНИИ).

3 **E-mail** **Аннотация на англ. языке**

4 **E-mail** **Акты экспертизы** или др. документы, разрешающие публиковать материал в открытой печати. СКАНКОПИЯ

5 **через БАНК** **Оплата** (ЦЕЛЕВОЙ-регистрационный взнос). Требуется оплатить одновременно с присылкой. Поступление денег мы контролируем сами. Оплата платежным поручением или через Сбербанк. При необходимости может быть выставлен счет, оформлен договор на услуги. Запрос счёта по электронной почте: nn.nto@mail.ru .

Реквизиты для перечисления взносов: Нижегородское НТОРЭС имени А.С. Попова, **ИНН 5260093486**, **КПП 526001001**, **БИК 042202747, Р/сч. 40703810023500000014** Нижегородский филиал ПАО АКБ «РОСБАНК», г. Нижний Новгород. **Кор/счет 30101810400000000747**
Назначение платежа: «Целевой взнос на конференцию СЭБР-2017 », **НДС не облагается**.

АДРЕС НАЦИОНАЛЬНОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:
603011 Нижний Новгород, Нижегородское НТОРЭС им. А.С. Попова, ул. Менделеева 15

Подробная информация и список принятых докладов публикуются на сайте: http://www.nto-nn.ru/

СЕКРЕТАРИАТ:

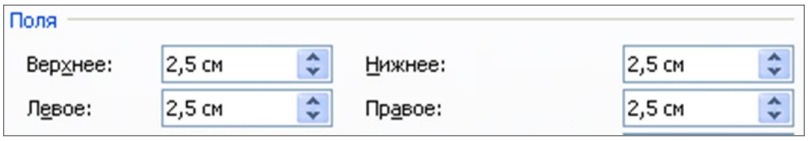
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ

Организационные вопросы	Приём докладов	Планирование, взносы, финансы,
ОБОЛЕНСКИЙ Сергей Владимирович ННГУ им. Н. И. Лобачевского Тел: +7 (831) 462-32-61 E-mail: obolensk@rf.unn.ru	E-mail конференции: losev.conference.2017@gmail.com **ШАПОШНИКОВ Дмитрий Евгеньевич** Ученый секретарь НРО НТОРЭС им А.С. Попова Моб.:+7 (951) 917-07-46 E-mail: shaposhnikov@pmk.unn.ru	**ТУЛЯКОВ Юрий Михайлович** Председатель НРО НТОРЭС им. А.С. Попова Моб.: +7 (910) 790–11-11 **ЯГОДКИН Вячеслав Леонидович** Заместитель Председателя НРО НТОРЭС им. А.С. Попова Тел/факс: +7 (831) 462-22-66 Моб.: +7 (910) 381-80-50 E-mail: nn.nto@mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

Тексты докладов подготавливаются только в редакторе Microsoft **Word** (любой версии) **объёмом до 4 страниц** формата А4. Названия файлов должны начинаться с фамилии авторов для идентификации материалов доклада, после в имени указывается, что это за файл (доклад, заявка, аннотация). Названия файлов пишутся русскими буквами. **Архивированные материалы не принимаются.**

Все поля страницы **2,5 см**



Образец оформления заголовка:

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (ARIAL 12pt, ПРОПИСНЫЕ, ПОЛУЖИРНЫЙ)

проф. Иванов А.Б., преп. Петров С.Д., студ. Сидоров Е.Ж. (TNR обычный, **10pt**.)

Название организации (TNR обычный, **10pt**.)

Сам текст доклада - Times New Roman (TNR) обычный, **10pt**. Абзац выравнивается по ширине (по двум сторонам), отступ первой строки - 5 мм, межстрочный интервал **одинарный**.

Страницы ***не*** нумеруются.

1. **Название доклада** оформляется ПРОПИСНЫМ шрифтом ARIAL **12pt.**
   Всё остальное – обычным шрифтом. Times New Roman обычный, **10pt**
2. **Авторы** указываю свой статус , фамилию и (после фамилии) инициалы. Если авторы из разных организаций, они нумеруют свою организацию верхним индексом перед названием, и себя соответствующей цифрой верхним индексом после инициалов. **Статус авторов, звание, учёная степень** перед фамилией сокращённо: профессор – **проф.,** доцент – **доц.,** ассистент – **асс.**, преподаватель или старший преподаватель – **преп.,** аспирант – **асп.,** инженер любой категории – **инж.,** студент – **студ.** Сотрудники предприятий и организаций указывают уровень квалификации (доктор, кандидат технических , физико-математических и т.п. наук) в общепринятом сокращении. Это же относится и к утверждённому научному званию.
3. **Название организации:** по возможности полное, затем сокращенное в скобках.
4. **Текст доклада**. **Начинать с аннотации на русском языке. Объём – 1300-1500 знаков, включая пробелы.**
5. **Литература** – слово "**Литература**" после текста доклада посередине, жирно. Далее перечень в виде списка. До нумерации – выравнивание слева.
6. **Аннотация на англ**. языке – перевод с русского языка, включая название доклада, авторов и организации. Размещать после литературы через 2 пробела.
7. ***Примечания:***
   Формулы оформляют во встроенном редакторе формул Microsoft **Word.** Страницы ***не*** нумеруют. Графика, фото, таблицы в тексте доклада в **черно-белом** варианте (печать ч/б). Контакты с автором доклада можно указать в самом конце, после списка литературы, перед аннотацией на английском, в произвольной форме. Суммарно весь доклад *не* должен превышать **4 стр**. формата **А-4**

Материалы, не отвечающие данным требованиям, *не* могут быть опубликованы!